



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران.
۹-۱۱ بهمن ۱۳۹۷



عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی آلی مبتنی بر پایه PEDOT:PSS/CuPC/C60 و PEDOT:PSS/ZnPC/C60

مهناز قاضی، علی اصغر شکری

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده - در این مقاله، با استفاده از مدل اپتیکی نرم افزار شبیه ساز Gpvdms مبتنی بر روش ماتریس انتقال عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی آلی مبتنی بر پایه PEDOT:PSS/CuPC/C60 و PEDOT:PSS/ZnPC/C60 را بررسی کرده ایم. وابستگی کمیت های تراکم و جذب فوتونها، چگالی جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز و همچنین بازده تبدیل توان و عامل پرشدگی به ضخامت لایه های فعال محاسبه شده است. نتایج محاسباتمان نشان می دهد که مقادیر کمیت های مذکور برای ضخامت بهینه ۳۰ nm لایه فعال CuPC بیشتر از ضخامت بهینه ۱۵ nm لایه فعال ZnPC است به طوری که ساختار نامتجانس بر پایه فتالوسیانین مس می تواند به عنوان سلول خورشیدی با عملکرد بهتری معرفی می شود. نتایج این مقاله ممکن است در طراحی ادوات اپتوالکترونیکی و سلول خورشیدی آلی مفید باشد.

کلید واژه- بازده تبدیل توان، تراکم و جذب فوتونها، چگالی جریان اتصال کوتاه، سلول خورشیدی آلی

Optical performance of an organic solar cell based on PEDOT: PSS/CuPC/C60 and PEDOT: PSS/ ZnPC/C60

Mahnaz Gahazi, Aliasghar Shokri

Department of physics, Payam Noor University (PNU), P.O.Box 19395-3697, Tehran, Iran

Abstract- In this paper, using optical model of Gpvdms simulator software based on the transfer matrix, we have investigated the optical performance of organic solar cell based on PEDOT: PSS/CuPC/C60 and PEDOT:PSS/ZnPC/C60. The active layer thickness dependence of the density and photon absorption, short circuit current density, the feedback-voltage, the efficiency of the power conversion and filling factor are calculated. The results indicate that the measured values of all the parameters mentioned above for the optimum thickness of 30 nm of the active layer of CuPC are greater than the optimal thickness of 15 nm of the active layer ZnPC have been. Our results may have important applications for building blocks in the organic solar cell and optoelectronic devices

Keywords: Power conversion, Photon density and absorption, Short circuit current density, Organic solar cell

مقدمه

اکسایتون‌های ایجادشده در یک لایه متناسب با تعداد فوتون های جذب شده است و از اینرو، $|E_{j(x,\lambda)}|^2$ به‌طور مستقیم نشان‌دهنده تولید اکسایتون‌های تولیدشده در هر نقطه است. آهنگ تولید اکسایتون با معادله (۲) داده می‌شود [۲]:

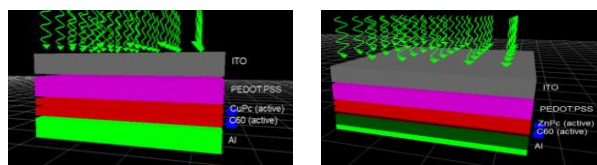
$$G_{j(x)} = \frac{1}{hc} \int_{350}^{800} Q_{j(x,\lambda)} \lambda d\lambda \quad (2)$$

در این رابطه، h ثابت پلانک، c سرعت نور و λ طول موج نور فرودی می‌باشند. در حالت ایده‌آل می‌توان با جمع تمامی اکسایتون‌ها در ناحیه فعال، به رابطه بیشترین چگالی جریان اتصال کوتاه دست پیدا کرد. بنابراین، چگالی جریان اتصال کوتاه ایجادشده از رابطه (۳) محاسبه می‌شوند [۳].

$$J_{sc} = e \int G_{j(x)} dx \quad (3)$$

بررسی نتایج

دو نوع ساختار بکار برده شده در شکل (۱) نمایش داده شده است:



شکل ۱: ساختارسلول خورشیدی آلی متشکل از لایه فعال CuPC/C60 و ZnPC/C60

جدول ۱: مقایسه پارامترهای اپتیکی ساختار A با ضخامت ۳۰ nm و ساختار B با ضخامت ۱۵ nm

Device	Thickness (nm)	FF	PCE (%)	V _{oc} (V)	J _{sc} (Am ⁻²)
A	30	0.733	13.086	0.841	-211.94
B	15	0.700	9.315	0.721	-184.19

ثابت‌های اپتیکی (n , k) لایه‌های CuPc, c60, ZnPc از مراجع استخراج شده است [۴ و ۵]. ابتدا برای یافتن ضخامت بهینه، نمودار چگالی جریان مدار کوتاه برحسب

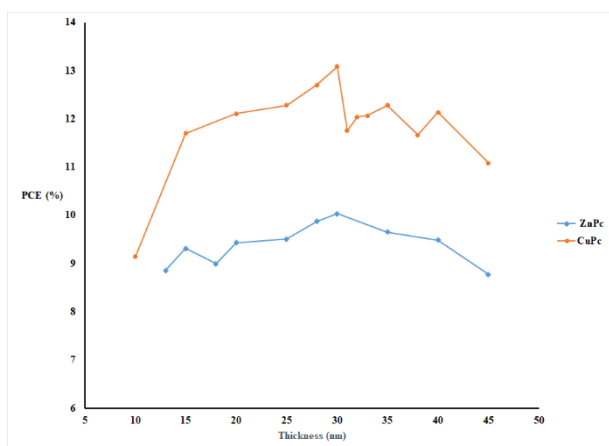
در دهه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای توسعه سلول‌های خورشیدی در جهت کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش بازده آنها صورت گرفته است. این تلاش‌ها به دنبال استفاده از فرآیندهایی بوده‌اند که به دمای فرآیند بالا، زمان‌های طولانی فرآیند و زیر لایه‌های سخت و گران‌قیمت نیازی نداشته باشند. در این میان، فتالوسیانین‌های فلز مد نظر است، که در این مقاله سلول خورشیدی آلی را به صورت یک چندلایه‌ای نامتجانس شامل نیم‌رساناهای مختلف از نوع دهنده و گیرنده که به وسیله یک لایه میانی (لایه فعال) از نوع ماده آلی (فتالوسیانین) انتخاب می‌کنیم. با در نظر گرفتن عنصر مرکزی فتالوسیانین از نوع فلزات مختلف مانند مس و روی، بازده و کمیت‌های مختلف سلول خورشیدی (جریان مدار کوتاه، ولتاژ مدار باز، ضریب جذب و ضریب عامل پرشدگی) مورد بحث قرار می‌گیرد. در این مقاله، با استفاده از مدل اپتیکی نرم‌افزار شبیه-ساز Gpvdms، سلول خورشیدی با لایه‌های فعال ZnPC/c60 و CuPC/c60 مورد مطالعه قرار گرفته است.

مدل اپتیکی

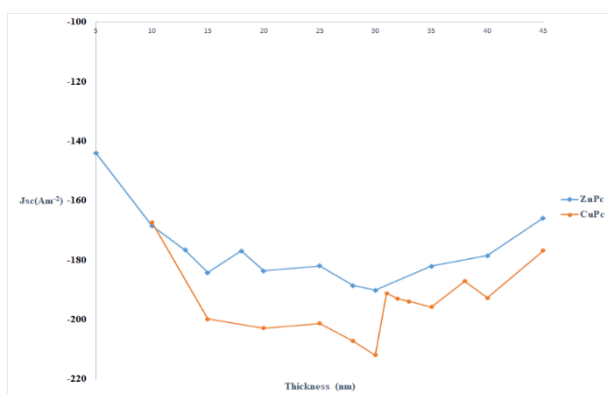
مدل اپتیکی بر اساس روش ماتریس انتقال می‌باشد که اولین بار توسط پترسون و همکارانش بر روی سلول خورشیدی آلی مورد استفاده قرار گرفت [۱]. از آنجا که تعداد اکسایتون‌ها در یک موقعیت خاص در یک ساختار به‌طور مستقیم وابسته به انرژی جذب شده توسط مواد است می‌توان با در نظر گرفتن عمودی بودن نور فرودی، انرژی جذب شده در مکان x لایه فعال (لایه j) را توسط رابطه (۱) محاسبه نمود:

$$Q_{j(x,\lambda)} = \frac{1}{2} C \epsilon_0 \alpha_j \eta_j |E_{j(x,\lambda)}|^2, \alpha_j = \frac{4\pi k_j}{\lambda} \quad (1)$$

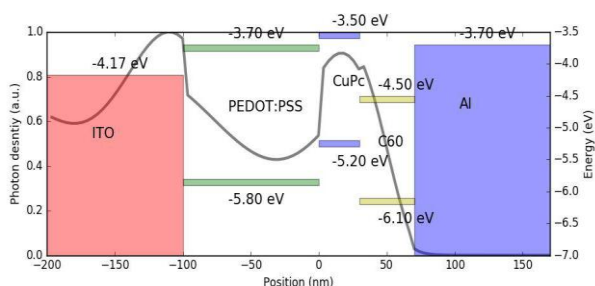
این، به این معنی است که انرژی جذب شده در موقعیت x در ساختار لایه‌ای متناسب با سرعت نور C و ضریب گذردهی خلا و α_j ضریب جذب و η_j ضریب شکست لایه فعال و $|E_{j(x,\lambda)}|^2$ مربع میدان الکتریکی درون لایه فعال است. تعداد



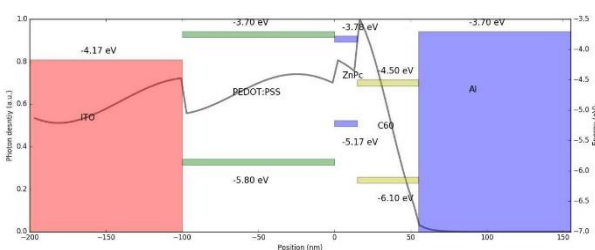
شکل ۲- بازده تبدیل توان برحسب ضخامت‌های دو ساختار A و B



شکل ۳- چگالی جریان اتصال کوتاه برحسب ضخامت دو ساختار A و B



شکل ۴- نمودار تراکم فوتون در تمامی لایه‌های دستگاه A



شکل ۵- نمودار تراکم فوتون در تمامی لایه‌های دستگاه B

با مقایسه شکل‌های ۶ و ۷ مشاهده می‌کنیم که ماکزیمم جذب چگالی فوتونها در CuPc و ZnPc هر دو در ۱ می‌باشد

ضخامت را برای سلول با لایه فعال CuPc/c60 (ساختار A) و لایه فعال ZnPc/c60 (ساختار B) بدست آورده‌ایم (شکل ۲ ببینید).

در ابتدا توسط نرم افزار شبیه ساز Gpvdms^۱ که اساس محاسبات عددی این شبیه ساز بر مبنای روش نیوتن رافسون و مبنای محاسبات اپتیکی و الکتریکی آن بر اساس روش پترسون می‌باشد. ضخامت‌های بهینه را برای بیشترین بازده تبدیل توان دو ساختار محاسبه نموده ایم و سپس مقایسه بین پارامترهای اپتیکی را انجام داده ایم. با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول ۱ مشاهده می‌شود که مقادیر تمام پارامترهای به دست آمده از دستگاه A با ضخامت بهینه ۳۰ nm بالاتر از دستگاه B با ضخامت بهینه ۱۵ nm می‌باشد. نحوه تغییر بازده تبدیل توان برحسب ضخامت لایه فعال در شکل ۲ ارائه شده است. البته لازم به ذکر است که در ضخامت ۱۵ nm و ۳۰ nm در لایه فعال ZnPc قله بازده داریم که بالاترین بازده در ضخامت ۳۰ nm لایه ZnPc رخ داده است اما به علت بالارفتن احتمال باز ترکیب در این ضخامت ما دستگاه شبیه ساز gpvdms را با ضخامت ۱۵ nm تنظیم نمودیم. با توجه به شکل ۳ مشاهده می‌کنیم که روند کاهش و افزایش چگالی جریان اتصال کوتاه در هر دو ساختار در ضخامت‌های مشابه، یکسان می‌باشد و در هر دو ساختار در ضخامت ۱۰ nm بیشترین چگالی جریان اتصال کوتاه را داریم و در ضخامت ۳۰ nm کمترین مقدار چگالی جریان اتصال کوتاه را داریم. با توجه به اینکه در این دو ساختار لایه های ZnPc و CuPc هر دو نقش دهنده را بر عهده دارند با مقایسه شکل‌های ۴ و ۵ در می‌یابیم که لایه CuPc نقش دهنده خود را بهتر ایفا می‌نماید و تراکم فوتونها در این لایه از دستگاه A بیشتر از لایه ZnPc ساختار B می‌باشد.

^۱General-purpose Photovoltaic Device Model (gpvdms)

مقاله برای بحث در مورد پارامترهای فتوولتائیک (ولتاژ مدار باز، فاکتور پرشوندگی، بازده تبدیل توان) این دو ساختار می‌توان استفاده نمود.

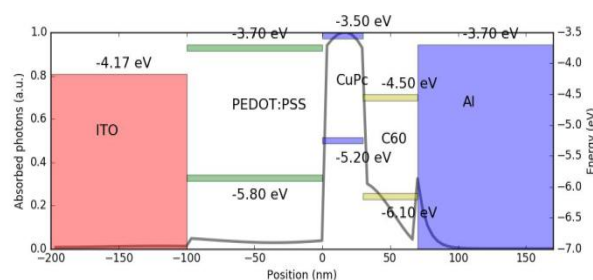
سپاسگزاری

از آقای مهندس هاشم حجتی‌راد به خاطر راهنمایی‌هایشان تشکر و قدردانی می‌کنیم.

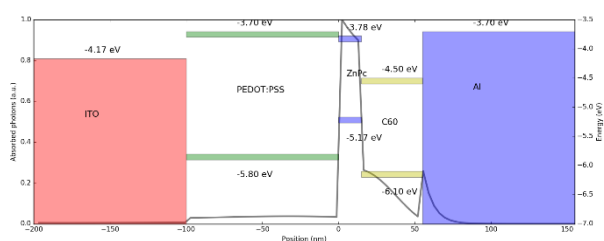
مرجع‌ها

- [1] A. A. Pettersson L., S. Roman L., Inganas O., Modeling photocurrent action spectra of photovoltaic devices based on organic thin films, **J. Appl. Phys.** 86 (1999) 487.
- [2] 2. Albrecht S., Schafer S., Lange I., Yilmaz S., Dumsch I., Allard S., Scherf U., Hertwig A., Neher D., Lightmanagement in PCPDTBT:PC70BM solar cells: A comparison of standard and inverted device structures,
- [3] 3. E. Petoukhoff C., K. Vijapurapu D., M. Ocarroll D., Computational comparison of conventional and inverted organic photovoltaic performance parameters with varying metal electrode surface workfunction, **Sol. Energy Mater. Sol. Cells**, 120, 572-583 (2014)..
- [4] 4. Monestier, F., Simon, J.-J., Torchio, P., Escoubas, L., Ratier, B., Hojeij, W., Lucas, B., Moliton, A., Cathelinaud, M., Defranoux, C., Flory, F. (2008). Optical modeling of organic solar cells based on CuPc and C₆₀. *Applied Optics*, 47(13), C251-C256.
- [5] 5. Senthilarasu, S., Velumani, S., Sathyamoorthy, R., Subbarayan, A., Ascencio, J. A., Canizal, G., Sebastian, P. J., Chavez, J. A., Perez, R. (2003). Characterization of zinc phthalocyanine (ZnPc) for photovoltaic applications. *Applied Physics A: Materials Science & Processing*, 77(3-4), 383-389.

اما با این تفاوت که در CuPc نمودار تقریباً در این محدوده به صورت سهمی می‌باشد اما در ZnPC به صورت خطی با یک نقطه ماکزیمم می‌باشد و سپس به شدت نزولی می‌گردد. طبق نمودارهای مربوطه به نظر می‌رسد که جذب فوتون‌ها در CuPc بیشتر می‌باشد.



شکل ۶- نمودار جذب فوتون در تمامی لایه‌های دستگاه A



شکل ۷- نمودار جذب فوتون در تمامی لایه‌های دستگاه B

نتیجه گیری

در این مقاله، عملکرد سلول خورشیدی آلی با استفاده از نرم-افزار شبیه‌ساز gpvdm که اساس کار آن روش ماتریس انتقال می‌باشد بررسی گردید. پارامترهایی چون ولتاژ مدار باز و چگالی جریان اتصال کوتاه و عامل پرشدگی و بازده تبدیل توان در ساختار A با ضخامت ۳۰ nm نانومتر دارای مقادیر بالاتری از ساختار B با ضخامت ۱۵ nm می‌باشد. زیرا با این حال که ساختار A در لایه دهنده خود دارای گاف انرژی بزرگتری می‌باشد اما نسبت به لایه دهنده ساختار B، دارای تراکم فوتونی و جذب فوتونی بهتری می‌باشد. در ادامه کار، از داده‌های این